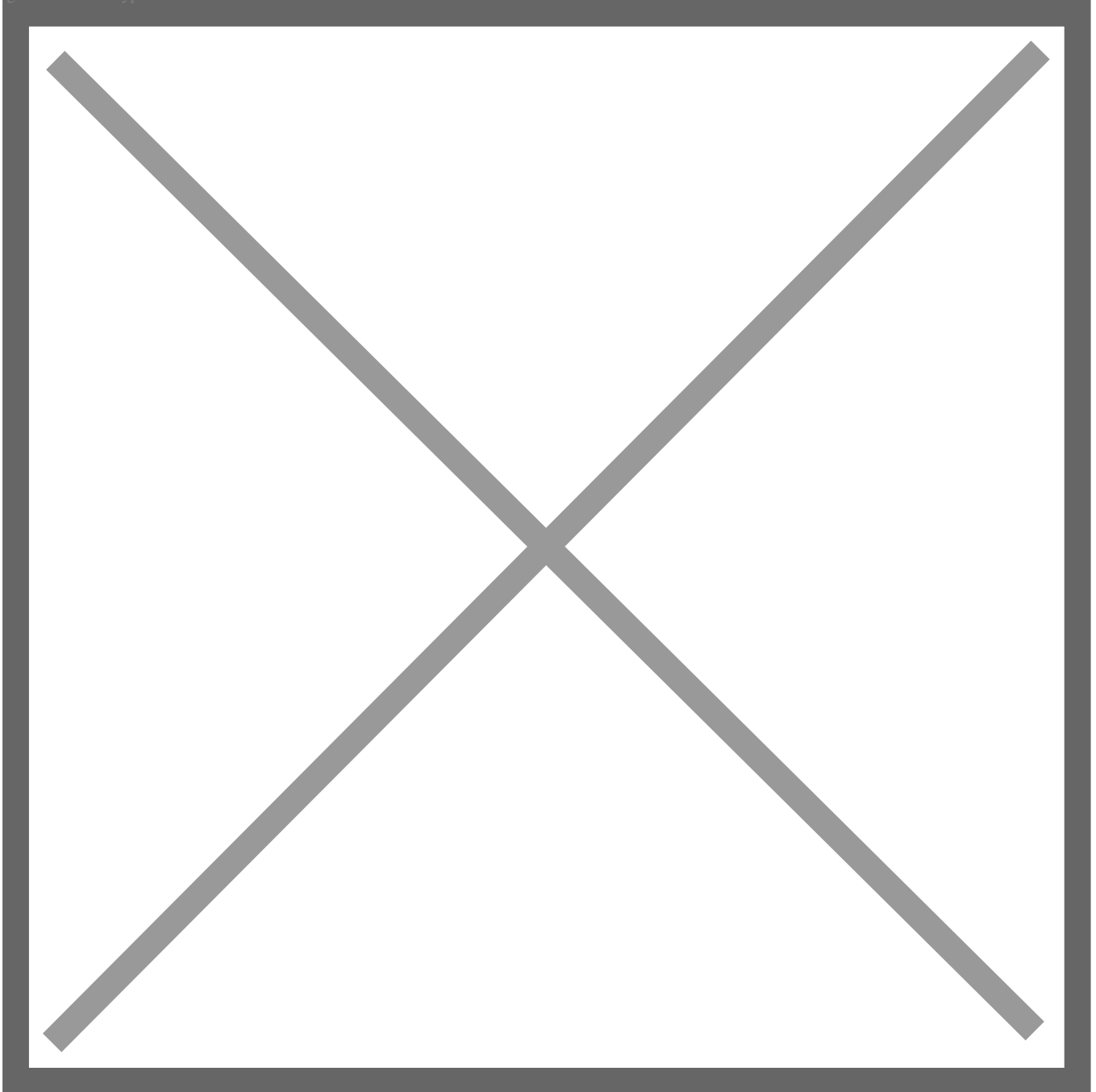


## Установка плазменного удаления фоторезиста Navigator

Image not found or type unknown



**Производитель:**

Plasma-Therm

**Цена:**

Цена по запросу

**Описание**

Установка плазменного травления Plasma-Therm Navigator предназначена для беззарядового удаления фоторезиста, низкотемпературного (50-150°C) и высокого температурного (150-250°C) снятия фоторезиста, удаления полимеров после процесса РИТ, очистки и сглаживания боковых стенок канавок после Bosch-процесса, очистки сложных 3D и МЭМС структур от органики. Установка позволяет проводить одиночную или групповую обработку пластин диаметром до 200 мм. Запатентованная технология HDRF (High Density Radical Flux) полностью исключает ионную составляющую процесса травления, что позволяет избежать внесения электрического заряда в полупроводниковую структуру. Установка может использоваться как для научно-исследовательских задач, так и для крупносерийного производства с автоматической загрузкой пластин из кассеты.

### **Область применения:**

- Беззарядовое удаление фоторезиста
- Низкотемпературное снятие фоторезиста (50 -150°C)
- Высокотемпературное снятие фоторезиста (150 -250°C)
- Удаление полимеров после процесса глубокого РИТ (Bosch-процесс)
- Очистка поверхности пластин перед процессом бондинга
- Очистка от органики боковых стенок структур с высоким аспектным соотношением (30:1)
- Очистка микростекол, МЭМС структур от органики

### **Особенности:**

- Отсутствие наведенного заряда, ионной бомбардировки во время процесса
- HDRF ICP-источник плазмы с высокой плотностью радикалов ( $>1e17 \text{ см}^{-3}$ )
- Быстрая перенастройка оснастки для проведения одиночной или групповой обработки пластин размером до 200 мм
- Опционально возможна конфигурация для двусторонней обработки пластин
- Uptime установки  $> 92\%$
- Простой интерфейс управления на базе Microsoft Windows 7 с цветным сенсорным дисплеем
- Опция определения Endpoint процесса
- Равномерность

### **Технические характеристики**

Модель	Navigator 8	Odyssey HDRF
Загрузка пластин	ручная	кассетная
Размер подложек	до 200 мм	до 200 мм
Тип обработки	Групповая (пластины до 200 мм) Одиночная (пластины до 200 мм)	Групповая (пластины до 200 мм) Двухсторонняя обработка
Нагрев подложки	до 250°C (регулируемый)	
Газовые линии	До 5 линий с цифровыми MFC	
Материал камеры	Алюминий с анодированным покрытием	Алюминий с анодированным покрытием
ВЧ ICP источник плазмы	1000 Вт 13,56 МГц	2000 Вт 13,56 МГц
Нагрев стенок камеры	До 250°C	До 250°C
Контроль давления	Автоматический	
Система управления	PLC+GUI	
Габариты (ШхГхВ)	780x860x1700 мм	1240x2090x2380 мм